

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ястребов Олег Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.05.2026 16:41:02
Уникальный программный ключ:
ca953a0120d891083f939673078ef1a989dae18a

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы»**

Инженерная академия

(наименование основного учебного подразделения (ОУП)-разработчика ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГЕТЕРОСТРУКТУРНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

(наименование дисциплины/модуля)

Рекомендована МССН для направления подготовки/специальности:

28.04.01 НАНОТЕХНОЛОГИИ И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА

(код и наименование направления подготовки/специальности)

Освоение дисциплины ведется в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОП ВО):

НАНОТЕХНОЛОГИИ

(наименование (профиль/специализация) ОП ВО)

2026 г.

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Технология производства гетероструктурных интегральных схем» входит в программу магистратуры «Нанотехнологии» по направлению 28.04.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» и изучается во 2 семестре 1 курса. Дисциплину реализует Базовая кафедра «Нанотехнологии и микросистемная техника». Дисциплина состоит из 6 разделов и 17 тем и направлена на изучение гетероструктурных интегральных схем и принципов их производства.

Целью освоения дисциплины является получение знаний, умений, навыков и опыта деятельности в области технологических процессов планарной технологии; основных приемов формирования структур элементов интегральных схем; принципов действия технологического оборудования и режимов выполнения технологических операций.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Технология производства гетероструктурных интегральных схем» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины)

Шифр	Компетенция	Индикаторы достижения компетенции (в рамках данной дисциплины)
ПК-5	Способность разрабатывать технологии изготовления наноструктурированных покрытий с заданными свойствами и проводить исследования их характеристик	ПК-5.1 Знает основные технологии изготовления наноструктурированных покрытий с заданными свойствами; ПК-5.2 Умеет проводить исследования характеристик наноструктурированных покрытий с заданными свойствами; ПК-5.3 Владеет методами разработки технологии изготовления наноструктурированных покрытий с заданными свойствами;
ПК-7	Способность разрабатывать современные технологические процессы изготовления наноэлектронных изделий	ПК-7.1 Знает основные современные технологические процессы изготовления наноэлектронных изделий; ПК-7.2 Владеет навыками разработки современных технологических процессов изготовления наноэлектронных изделий;
ПК-8	Способность разрабатывать новые технологические процессы производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	ПК-8.1 Знает основные современные технологические процессы производства микро- и наноразмерных электромеханических систем; ПК-8.2 Владеет навыками разработки новых технологических процессов производства микро- и наноразмерных электромеханических систем;

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО

Дисциплина «Технология производства гетероструктурных интегральных схем» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы высшего образования.

В рамках образовательной программы высшего образования обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения дисциплины «Технология производства гетероструктурных интегральных схем».

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению запланированных результатов освоения дисциплины

Шифр	Наименование компетенции	Предшествующие дисциплины/модули, практики*	Последующие дисциплины/модули, практики*
ПК-7	Способность разрабатывать современные технологические процессы изготовления нанoeлектронных изделий	Материалы наноструктурных установок;	Строение и химические свойства наночастиц; <i>Синтез композиционных материалов методом 3D принтинга**</i> ; <i>Синтез композиционных материалов методом электроспиннинга**</i> ; Преддипломная практика;
ПК-8	Способность разрабатывать новые технологические процессы производства микро- и наноразмерных электромеханических систем	Аддитивные технологии;	Углеродные нанотрубки, фуллерены и гидрофобная сажа; <i>Синтез композиционных материалов методом 3D принтинга**</i> ; <i>Синтез композиционных материалов методом электроспиннинга**</i> ; Преддипломная практика;
ПК-5	Способность разрабатывать технологии изготовления наноструктурированных покрытий с заданными свойствами и проводить исследования их характеристик	Аддитивные технологии;	Углеродные нанотрубки, фуллерены и гидрофобная сажа; Преддипломная практика;

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО

** - элективные дисциплины /практики

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Технология производства гетероструктурных интегральных схем» составляет «5» зачетных единиц.

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения образовательной программы высшего образования для очной формы обучения.

Вид учебной работы	ВСЕГО, ак.ч.		Семестр(-ы)
			2
<i>Контактная работа, ак.ч.</i>	51		51
Лекции (ЛК)	34		34
Лабораторные работы (ЛР)	0		0
Практические/семинарские занятия (СЗ)	17		17
<i>Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч.</i>	93		93
<i>Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч.</i>	36		36
Общая трудоемкость дисциплины	ак.ч.	180	180
	зач.ед.	5	5

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
Раздел 1	Технологические основы создания гетероструктурных интегральных схем	1.1	Фундаментальные технологические процессы	Основные технологические процессы производства гетероструктурных ИМС	ЛК
		1.2	Методы планарного изготовления	Принципы и особенности планарной технологии	ЛК
		1.3	Современные технологические решения	Анализ и характеристика современной технологии интегральных микросхем	ЛК
Раздел 2	Основные этапы обработки полупроводниковых подложек	2.1	Кристаллографическая подготовка	Методы ориентирования кристаллов и их значение для качества подложек	ЛК, СЗ
		2.2	Формирование геометрических и поверхностных параметров	Технологии механической обработки полупроводниковых подложек (шлифовка, полировка и др.)	ЛК, СЗ
Раздел 3	технологии легирования полупроводниковых подложек: методы и контроль параметров	3.1	Диффузионные методы легирования	Диффузия примесей в полупроводниках. Диффузия в потоке газа-носителя. Измерение параметров диффузионных слоёв.	ЛК, СЗ
		3.2	Ионно-лучевые методы легирования и постобработка	Легирование полупроводников ионным внедрением. Радиационные эффекты в кремнии. Отжиг имплантированного кремния.	ЛК, СЗ
Раздел 4	Технологии нанесения тонких плёнок на полупроводниковые подложки	4.1	Эпитаксиальные методы	Эпитаксиальное наращивание кремния: хлоридный и гидридный методы эпитаксии, молекулярно-лучевая эпитаксия кремния.	ЛК, СЗ
		4.2	Термические и химические методы	Термическое окисление кремния. Химическое осаждение тонких плёнок из газовой фазы.	ЛК, СЗ
		4.3	Вакуумные и плазменные методы напыления	Вакуумное напыление. Ионно-плазменное напыление тонких плёнок. Магнетронные системы напыления.	ЛК, СЗ
		4.4	Оборудование для нанесения плёнок	Схема вакуумной установки.	ЛК, СЗ
Раздел 5	Технологии формирования топологии интегральных схем	5.1	Литографические процессы	Фотолитография. Позитивные и негативные фоторезисты. Методы создания фотошаблонов. Электронолитография. Особенности литографии нанометровых размеров.	ЛК, СЗ
		5.2	Методы травления	Ионно-плазменное травление	ЛК, СЗ
Раздел 6	Современные технологии производства и сборки интегральных микросхем	6.1	Обеспечение электрической изоляции	Общие принципы изоляции элементов. Изоляция через p-n переходы. Применение диэлектрических слоёв для изоляции. Локальное окисление как метод изоляции.	ЛК, СЗ
		6.2	Базовые технологические маршруты	Производство изопланарных биполярных СБИС. Производство p-канальных МОП СБИС.	ЛК, СЗ
		6.3	Создание межэлементных соединений	Технологии металлизации интегральных схем. Реализация	ЛК, СЗ

Номер раздела	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы		Содержание темы	Вид учебной работы*
				разводки с использованием алюминиевых плёнок.	
		6.4	Завершающие операции и корпусирование	Общая схема сборки интегральных микросхем. Способы монтажа кристаллов на подложку. Технологии контактных соединений: термокомпрессия и УЗ-сварка.	ЛК, СЗ

* - заполняется только по **ОЧНОЙ** форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – практические/семинарские занятия.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Тип аудитории	Оснащение аудитории	Специализированное учебное/лабораторное оборудование, ПО и материалы для освоения дисциплины (при необходимости)
Лекционная	Аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная комплектом специализированной мебели; доской (экраном) и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Нет
Семинарская	Аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом специализированной мебели и техническими средствами мультимедиа презентаций.	Нет
Для самостоятельной работы	Аудитория для самостоятельной работы обучающихся (может использоваться для проведения семинарских занятий и консультаций), оснащенная комплектом специализированной мебели и компьютерами с доступом в ЭИОС.	Нет

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Смирнов В.И. Технология интегральных микросхем: Инфра-Инженерия, 2023 г., ISBN: 978-5-9729-1232-2

2. Нанотехнологии в электронике. Введение в специальность. Учебное пособие. Лозовский В.Н., Лозовский С. В.: Лань, 2025 г. ISBN: 978-5-507-47532-2

3. Корнеев В.А. Топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ: Проспект, 2021 г., Учебное пособие; ISBN: 978-5-392-33754-5

4. Физические основы нанотехнологий и наноматериалы. Учебное пособие. Смирнов В.И.: Инфра-Инженерия, 2023 г. ISBN: 978-5-9729-1246-9

5. Бунтов, Е. А. Современные устройства и элементы нанoeлектроники : учебнометодическое пособие / Е. А. Бунтов, А. С. Вохминцев, Т. В. Штанг. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : Изд-во Урал. ун-та, 2022. - 132 с. - ISBN 978-5-9765-5036-06

Дополнительная литература:

1. Кондрашин А.А., Лямин А.Н., Слепцов В.В. Современные технологии изготовления трехмерных электронных устройств: Учеб. пособие. – М.: Техносфера, 2019.– 210 с

2. K. Reinhardt, W. Kern. Handbook of silicon wafer cleaning technology. Thrid edition.2018. – 773 p

3. Нано- и биоконпозиты : монография / под ред. А. К.-Т. Лау, Ф. Хуссейн, Х. Лафди; пер. с англ. — 2-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 393 с. — (Нанотехнологии). — SBN 978-5-00101-727-1. - ISBN 978-5-00101-727-1

4. Наноэлектроника: теория и практика : учебник / В. Е. Борисенко, А. И. Воробьева, А. Л. Данилюк, Е. А. Уткина. - 5-е изд. - Москва : Лаборатория знаний, 2020. - 369 с. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 978-5-00101-732-5

5. Королев М.А., Крупкина Т.Ю., Путря М.Г. Технология, конструкции и методы моделирования кремниевых интегральных микросхем; Просвещение/Бином, 2012 г., SBN: 978-5-94774-585-6

6. Мочалкина О.Р.; Березин А.С. Технология и конструирование интегральных микросхем: Учеб. пособие для вузов, Березин А.С., Мочалкина О.Р., М., Радио и связь, 1992

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на основании заключенных договоров

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН

<https://mega.rudn.ru/MegaPro/Web>

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>

- ЭБС Юрайт <http://www.biblio-online.ru>

- ЭБС «Консультант студента» www.studentlibrary.ru

- ЭБС «Знаниум» <https://znanium.ru/>

2. Базы данных и поисковые системы

- Sage <https://journals.sagepub.com/>

- Springer Nature Link <https://link.springer.com/>

- Wiley Journal Database <https://onlinelibrary.wiley.com/>

- Научометрическая база данных Lens.org <https://www.lens.org>

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при освоении дисциплины/модуля:*

1. Курс лекций по дисциплине «Технология производства гетероструктурных интегральных схем».

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины **в ТУИС!**

РАЗРАБОТЧИК:

Доцент

Должность, БУП

Подпись

Макеев Мстислав

Олегович

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ БУП:

Заведующий кафедрой

Должность БУП

Подпись

Попов Сергей Викторович

Фамилия И.О.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОП ВО:

Доцент

Должность, БУП

Подпись

Агасиева Светлана

Викторовна

Фамилия И.О.